High-speed data recording

[We have the software of the English version.]

印刷プレビュー

2008/06/06 11:30:10 エレクトロケミカルマイグレーション試験データ CH5 : 試験名称 fast DCバイアス電圧 30.0 V メモ データ収録間隔 1分 ECM判定問値 レベル① 1.000E+006Ω 2008/06/06 10:51:25 終了 (予定) 2008/06/06 11:51:25 試験期間 開始 経過 合計 ECM判定閾値 レベル② 試驗時間 0時間3分 1時間0分 2.000E+005Ω 1.0E+14 33.0 It catch a resistance value change between only 49msec, and an 1.0E+13 examination is finished immediately 1.0E+12 Time(sec) Time(hh:mm:ss) DC Bias(V) Current(A) Resistance(ohm) Data 1.00+11 1 10.073 00:10.1 29.99976 6.72E-08 4.47E+08 2 60.004 01:00.0 29.99982 8.15E-08 3.68E+08 1.0E+10 02:00 3 120.007 11E-08 4.22E+08 <u>∕t</u>:49msec 03.04 .09E-08 3.71E+08 1.0E+09 180.011 4 5 219.804 3.26E-05 03:39.0 9.12E+05 1.0E+08 6 219.853 11.60268 6.54E-05 03:39.9 1.77E+05 1.000+07 1.0E+06 It records without missing a leak touch ! Because it can stop BIAS immediately, it prevent a damage of dendrite ! 1.00+05 * The most speed is 16msec 1.0E+04 0h 0h 0h 0h 1.0E+03 00m00s 10 m 00 s 20m00s 30 m 00 s 40 m 00 s 0.0 試験名称とメモを削除 閉じる